



请输入关键词 

- 网站首页
- 实验室概况
- 新闻中心
- 科研团队
- 科学研究
- 开放交流
- 人才培养
- 仪器设备
- 学术简报
- English

您现在所在位置: 首页 > 科学研究 / 授权专利

授权专利 

## 部分国家发明专利 (2)

作者: 文章来源: 发布时间: 2011-12-20 阅读次数: 1009

◇ 先刻槽自对准槽栅CMOS器件制方法	00114824.9
◇ 后刻槽自对准槽栅CMOS器件制造方法	00114822.2
◇ 单面抛光衬底外延薄膜厚度和光学参数的测量方法	200510042863.6
◇ GaAs基材料上原位淀积高介电常数 $Al_2O_3$ 和金属膜的方法	200510096232.2
◇ GaN基发光二极管表面粗化的处理方法	200710199280.3
◇ 集成电路功能成品率估计方法	200710018858.0
◇ 用于片上长线互连的差分接口电路	200810018339.9
◇ 一种AlGaIn/GaN HEMT器件的隔离方法	200810017836.7
◇ 一种新型增强型AlGaIn/GaN HEMT器件的实现方法	200810017835.2
◇ GaN多层量子点光电材料的制作方法	200810150272.4
◇ AlGaIn/GaN MISHEMT器件的制备方法	200810150647.4
◇ AlGaIn材料表面淀积 $Al_2O_3$ 界面过滤层的抑制方法	200810150645.8
◇ 电磁加热装置	200810232210.8
◇ 绝缘栅型源场板异质结场效应晶体管	200810232512.5
◇ 凹槽绝缘栅型复合栅场板高电子迁移率器件	200810232518.2

 打印本页  关闭窗口

© 2013- 2021 西安电子科技大学宽带隙半导体国家重点实验室 版权所有

地 址: 陕西省西安市雁塔区太白南路2号

电 话: 029-88201759-855

E\_mail: jiabol@xidian.edu.cn

邮 编: 710071

Design & Support 技术支持: 新势力网络



/ 西安电子科技大学微电子学院 / 西安电子科技大学科学研究院  
/ 宽禁带半导体国家工程研究中心  
/ 宽禁带半导体材料教育部重点实验室 / 中科院上海微系统与信息所  
/ 中科院半导体所 / 清华大学信息科学技术学院  
/ 中科院微电子所 / 北京大学软件与微电子学院  
/ 西安电子科技大学